

Флуктуации параметра порядка и температура сверхпроводящего перехода в квази-2D металлах с произвольной плотностью носителей

В. М. Локтев

*Институт теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова НАН Украины,
Украина, 252143, г. Киев, ул. Метрологическая, 14-б
E-mail: vloktev@gluk.apc.org*

В. М. Турковский

Киевский университет им. Т. Г. Шевченко, Украина, 252127, г. Киев, пр. Ак. Глушкова, 6

Статья поступила в редакцию 17 марта 1998 г.

Показано, что учет флуктуаций параметра порядка приводит к степенной зависимости температуры сверхпроводящего перехода квази-2D металлов от вероятности перескоков фермионов между слоями. Найдена зависимость этой температуры от концентрации носителей для модели с косвенным межфермионным притяжением и установлено, что сам переход происходит при меньших температурах, чем это следует из теории БКШ.

Показано, що урахування флуктуацій параметра порядку приводить до ступеневі залежності температури надпровідного переходу квазі-2D металу від ймовірності перескоків ферміонів між шарами. Знайдено залежність цієї температури від концентрації носіїв для моделі з непрямим міжферміонним притяганням та встановлено, що сам перехід відбувається при менших температурах, ніж це виходить з теорії БКШ.

PACS: 67.20.+k, 74.20.-z, 74.25.-q, 74.62.-h

Введение

Проблема кроссовера от сверхтекучести (или бозе-эйнштейновской конденсации) составных бозонов к сверхпроводимости типа БКШ стала особенно актуальной в последние несколько лет. Это обусловлено отчетливо наблюдаемыми особенностями сверхпроводящего перехода в высокотемпературных сверхпроводниках (ВТСП), поведение которых существенно зависит от концентрации n_f в них свободных носителей (см., например, [1–5]). Тем не менее следует отметить, что, даже опуская упоминание о ранних (до создания теории БКШ) попытках свести само явление сверхпроводимости к бозе-эйнштейновской конденсации (см. прекрасную, посвященную истории и физике сверхпроводимости, книгу Игоря Михайловича Дмитренко [6]), вопросы кроссовера интенсивно обсуждались много раньше, на рубеже 60–70-х годов, в связи с обнаружением аномалий проводимости металл-аммиачных растворов. Для

их объяснения Дмитренко и Кулик привлекли идею о туннелировании и сверхтекучести локальных пар [7], образование которых предполагалось обусловленным сильным незапаздывающим взаимодействием U (использовалась модель Хаббарда с $U < 0$), а температура перехода T_c оказывалась пропорциональной $n_f^{2/3}$, что соответствовало возможному сценарию бозе-конденсации пар, сформировавшихся в 3D системе при $T > T_c$. В работе [7] не рассчитывался химический потенциал μ ферми-частиц (носителей), который в подобной ситуации должен, как хорошо известно [8,9], быть отрицательным, т.е. соответственно ферми-поверхность должна была отсутствовать.

При тех же предположениях (пренебрежение флуктуациями) в 2D системах $T_c \sim n_f$, что с прекрасной точностью и наблюдается [1,10–12], если иметь в виду слабо допированные образцы ВТСП. А поскольку соответствующие медные

оксиды в хорошем приближении могут быть отнесены к $2D$ системам, упомянутое концентрационное поведение T_c должно, казалось бы, свидетельствовать о бозе-конденсации локальных пар, которая положена в основу интерпретации и некоторых других экспериментальных данных [13] (см. также обзор [5]). Это, однако, не согласуется с фотоэлектронными спектрами (ARPES) [14,15], демонстрирующими существование в металлических фазах ВТСП ферми-поверхности, а следовательно, и положительную величину μ , и тем самым отсутствие пар в \mathbf{r} -пространстве. Кроме того, реальные медные оксиды, строго говоря, квазидвумерны, что является принципиальным с точки зрения возможности формирования в них однородного (в частности, сверхпроводящего) параметра порядка. Наконец, притягивающее фермион-фермионное взаимодействие в проводниках любой размерности вряд ли может быть запаздывающим.

Поэтому в настоящей работе, посвященной И. М. Дмитренко, 70-летие которого мы отмечаем в июле этого года, делается попытка рассмотреть кроссовер на основе более реальной, чем в [7], модели, а именно: модели с косвенным (в рамках простейшего гамильтониана Фрелиха) межфермионным притяжением. Мы также обобщаем подход, развитый в [16,17] для нахождения фазовой $T-n_f$ диаграммы $2D$ металлов с произвольной плотностью носителей, на случай наличия третьего измерения, проявляющегося благодаря учету межслоевого (джозефсоновского) туннелирования. Как будет видно, при малой его вероятности величина T_c оказывается значительно меньше среднеполевой ($T_c^{MF} \equiv T_c^{BCS}$), которая формально следует из формулы БКШ. При этом в отличие от случая запаздывающего притяжения учет запаздывания обеспечивает различное поведение T_c и T_c^{MF} при изменении n_f даже в той области концентраций, в которой общепринятое предположение (см. [3,5]) теории БКШ о справедливости равенства $\mu = \epsilon_F$ (ϵ_F — энергия Ферми), уже выполняется. Еще одной нерешенной задачей физики ВТСП остается поведение функции $T_c(n_f)$ в области больших n_f

(сильное допирование), где она для большинства купратных соединений достаточно быстро падает до нуля [18–20]. Мы высказываем предположение, что такое поведение может быть обусловлено вызванной допированием деградацией длинноволновых промежуточных бозонов (в дальнейшем упоминаемых как эйнштейновские фононы), обмен которыми вызывает притяжение между носителями*.

Формулировка модели

Рассмотрим систему параллельных плоскостей. Одноэлектронные состояния в каждой из них характеризуются квазимпульсом и спином, а вероятность межплоскостного перескока будем считать малой. Определенная подобным образом система в принципе аналогична той, которая впервые изучалась Ефетовым и Ларкиным [23] (см. также [24]), проанализировавшими квази- $1D$ ситуацию в приближении БКШ. В случае квази- $2D$ электронов, взаимодействующих с фононами, плотность гамильтониана системы может быть записана в виде ($\hbar = 1$)

$$H = -\sum_{i,\sigma} \left[\psi_{\sigma}^{\dagger}(x_j) \left(\frac{\nabla^2}{2m} + \mu \right) \psi_{\sigma}(x_j) + g_{\text{ph}} \psi_{\sigma}^{\dagger}(x_j) \psi_{\sigma}(x_j) \phi(x_j) \right] + H_{\text{ph}} + t_J \sum_j \psi_{\uparrow}^{\dagger}(x_j) \psi_{\downarrow}^{\dagger}(x_j) \psi_{\downarrow}(x_{j-1}) \psi_{\uparrow}(x_{j-1}), \quad (1)$$

$$x_j \equiv (\mathbf{r}_j^{2D}, t).$$

В (1) приняты обозначения, согласно которым j нумерует проводящие плоскости; $\psi_{\sigma}(x_j)$ и $\phi(x_j)$ — операторы электронного и фононного полей j -й плоскости; g_{ph} — константа их связи; m и $\sigma = \uparrow, \downarrow$ — масса и спин фермионов; $t_J \sim \sim |t_{\text{coh}}|^2/W$ — константа джозефсоновского (двухчастичного) туннелирования, чья роль, несмотря на его слабость, в поперечном относительно купратных слоев транспорте в ВТСП считается весьма существенной (см. [25]); t_{coh} — амплитуда когерентного перехода электрона между ближайшими плоскостями, W — ширина зоны проводимости; H_{ph} —

* В качестве аналогии упомянем низкочастотные спиновые флуктуации, спектр которых по мере увеличения n_f становится диффузионным [21,22], что, в свою очередь, указывает на подавление дальнего магнитного порядка в исходно АФМ упорядоченных медно-кислородных слоях ВТСП. С другой стороны, пренебрежение дисперсией промежуточных бозонов позволяет решить получаемые уравнения аналитически. Самосогласованное же рассмотрение магнитоэлектронной задачи в полной мере в настоящее время едва ли возможно.

гамильтониан свободного бозе-поля, которое мы ради простоты будем считать бездисперсионным и характеризующимся частотой ω_0 . Заметим, что вследствие ионности соединений ВТСП именно оптические слабо диспергирующие фоновые ветви колебаний часто упоминаются в качестве вероятных промежуточных бозонов, обеспечивающих достаточное для достижения высоких T_c притяжение [26–30].

Пропагатор свободных бозонов, определяющий это притяжение, имеет стандартный вид [31]:

$$D(\omega) = \frac{2\omega_0}{\omega^2 - \omega_0^2 + i\delta}, \quad \delta \rightarrow 0, \quad (2)$$

который мы ниже несколько искусственно изменим, чтобы учесть следующие физические обстоятельства: полагаем, что по мере увеличения n_f длинноволновые бозоны с $\mathbf{k} \lesssim \mathbf{k}_{\min}$ становятся сильно затухающими и «выбывают» из числа переносчиков межфермионного взаимодействия, при этом граничный импульс \mathbf{k}_{\min} пропорционален импульсу Ферми \mathbf{k}_F , так что $k_{\min} = \alpha k_F \equiv \alpha \sqrt{2m\varepsilon_F}$, где α — некоторый свободный параметр. Напомним, что для свободных 2D-фермионов с квадратичным законом дисперсии $\varepsilon_F = \pi n_f / m$ [22]. Формальное выражение такого предположения сводится к замене (2) пропагатором

$$D(\omega, \mathbf{k}) = D(\omega) \theta(k - k_{\min}), \quad (3)$$

очевидно, совпадающим с $D(\omega)$ при $n_f = 0$.

Зная (1) и (3) и вводя параметр порядка $\Phi_j(x, y) = \omega_0 \langle \Psi_\uparrow(x_j) \Psi_\downarrow(y_j) \rangle$, нетрудно методом, предложенным в работах [16,17] (см. также обзоры [5,32]), вычислить плотность эффективного термодинамического потенциала Ω системы, с помощью которого можно исследовать ее сверхпроводящие свойства. Основу метода составляет представление модуль–фаза для функции $\Phi_j(x, y) = \Delta_j(x, y) \exp[i\theta_j(x, y)]$, которая предполагается неоднородной, поскольку дальнейшее однородное упорядочение в чистой 2D системе при конечных температурах, как известно, невозможно. Эта параметризация удобна и физически оправдана еще и потому, что отсутствие такого упорядочения обусловлено именно тепловыми флуктуациями фазы параметра порядка.

Однако при таких, достаточно общих, предположениях найти Ω не удастся, поэтому одним из допустимых приближений является пренебрежение неоднородностью и флуктуациями

модуля параметра порядка, приводящие к равенству $\Delta_j(x, y) = \Delta(n_f, T) \equiv \Delta$. Другим — предположение о малости флуктуаций фазы, или малости величин $\nabla_j \theta_j(x, y)$, что позволяет рассчитать Ω с точностью до $[\nabla_j \theta_j(x, y)]^2$ (длинноволновое приближение).

Тогда, выполняя необходимые вычисления, фактически повторяющие изложенные в [16], можно прийти к выражению

$$\begin{aligned} \frac{\Omega}{N_c} = & \Delta^2 - \\ & - \int \frac{d\omega d\mathbf{k}}{(2\pi)^3} \left[2T \ln \operatorname{ch} \frac{\sqrt{\xi^2(\mathbf{k}) + \Delta^2}}{2T} - \xi(\mathbf{k}) \right] D(\omega, \mathbf{k}) + \\ & + \int_0^{1/T} d\tau \int dr^{2D} J(\mu, \Delta, T) (\nabla\theta)^2 - \\ & - \frac{t_j \Delta^2}{N_c} \int dx \left\{ 1 - \cos [\theta_j(x, x) - \theta_{j-1}(x, x)] \right\}, \end{aligned} \quad (4)$$

в котором коэффициент

$$\begin{aligned} J(\mu, \Delta, T) = & \frac{1}{16\pi} \times \\ & \times \left\{ \sqrt{\mu^2 + \Delta^2} + \mu + 2T \ln \left[1 + \exp \left(- \frac{\sqrt{\mu^2 + \Delta^2}}{T} \right) \right] \right\} - \\ & - \frac{T}{8\pi} \left[1 - \left(\frac{\Delta}{2T} \right)^2 \frac{\partial}{\partial(\Delta/2T)} \right] \int_{-\mu/2T}^{\infty} dx \frac{x + \mu/2T}{\operatorname{ch}^2 \sqrt{x^2 + (\Delta/2T)^2}} \end{aligned} \quad (5)$$

является величиной, играющей роль жесткости относительно неоднородных «сдвиговых» деформаций параметра порядка в плоскости его определения, а $\xi(\mathbf{k}) = \mathbf{k}^2/2m - \mu$. При записи выражений (4) и (5) опущен индекс j в тех слагаемых, где он несуществен, и введено число N_c плоскостей на единицу длины вдоль оси \mathbf{c} , перпендикулярной им. Таким образом, найденное выражение для Ω является исходным для получения уравнений, описывающих поведение характерных температур в зависимости от n_f . Заметим, что выражение для эффективного потенциала по форме согласуется с полученным Абрикосовым [24] выражением, предполагавшим, что межплоскостное туннелирование осуществляется через резонансные

двухуровневые центры, конечное количество которых всегда присутствует между проводящими слоями реальных образцов ВТСП. Кроме того, коэффициент (5) в [24] считался равным плотности сверхпроводящего конденсата.

Фазовая диаграмма системы

Прежде всего следует сказать, что в исследуемой квази-2D модели, как и в 2D, имеется не одна, а две характерных температуры [16,23]: T_c^{BCS} , при которой возникает и начинает «упорядочиваться» модуль параметра порядка Δ (разумеется, зависящий от T , а также n_f), и T_c , являющаяся истинной критической температурой и возникающая как следствие квазидвумерности системы (в 2D случае роль критической играет температура Березинского—Костерлица—Таулесса [5,16]). При T_c^{BCS} никакого спонтанного нарушения непрерывной симметрии оператора (1) не происходит, и эта температура, будучи характерной для относительно быстрого формирования величины Δ , критической не является. Ниже нее модуль $\Delta \neq 0$, но недиагональный дальний порядок из-за развитых длинноволновых поперечных флуктуаций отсутствует вплоть до точки $T = T_c$. Это, в свою очередь, означает, что в области $T_c \lesssim T \lesssim T_c^{BCS}$ волновые функции пар в плоскостях некогерентны, а их фазы случайны в различных областях и плоскостях.

Хотя T_c^{BCS} не является критической, ее поведение легко найти, записав уравнение для Δ в приближении самосогласованного поля (приближение БКШ):

$$\Delta = -ig_{ph}^2 \int \frac{d\omega d\mathbf{k}}{(2\pi)^3} \frac{D(\omega, \mathbf{k})\Delta}{\omega^2 - \xi^2(\mathbf{k}) - \Delta^2 + i\delta}, \quad (6)$$

что является прямым следствием выполнения условия

$$\left. \frac{\partial \Omega}{\partial \Delta} \right|_{\mathbf{v}\theta=0, t_f=0} = 0$$

минимальности эффективного потенциала в пренебрежении межслоевыми перескоками. В (6) имеется неизвестный химический потенциал, уравнение для которого выводится из стандартного определения

$$\left. \frac{\partial \Omega}{\partial \mu} \right|_{\mathbf{v}\theta=0, t_f=0} = -n_f$$

и имеет вид

$$\sqrt{\mu^2 + \Delta^2} + \mu + 2 \ln \left[1 + \exp \left(-\frac{\sqrt{\mu^2 + \Delta^2}}{T} \right) \right] = 2\varepsilon_F. \quad (7)$$

Тем самым уравнения (6) и (7) образуют замкнутую самосогласованную систему, решения которой проанализированы в [16]. Явная зависимость $T_c^{BCS}(n_f)$ и $\mu(T_c^{BCS}, n_f)$ прямо следует из (6) и (7) после использования критерия $\Delta \rightarrow 0$, задающего критическую линию в том же приближении.

Температура T_c находится с помощью того же выражения (4), но с учетом последнего слагаемого, поскольку она соответствует глобальному (3D) упорядочению. В предполагаемом нами случае слабого туннелирования, по-видимому, соответствующем соединениям ВТСП, искомая температура является температурой установления единой фазы $\theta_j(x, y) = \theta$ во всех слоях, что можно, следуя [23,24], связать с единым значением $\langle \cos \theta \rangle \neq 0$, становящемся тем самым параметром порядка, который находится из уравнения [23]

$$\langle \cos \theta \rangle = \left\{ \int D\theta \exp \left[-\frac{\Omega^{MF}(\theta)}{T} \right] \right\}^{-1} \times \int D\theta \cos \theta \exp \left[-\frac{\Omega^{MF}(\theta)}{T} \right], \quad (8)$$

где

$$\begin{aligned} \Omega^{MF}(\theta) &= \\ &= N_c \int dr^{2D} [J(\mu, \Delta, T)(\nabla\theta)^2 - t_f \Delta^2 \langle \cos \theta \rangle \cos \theta] \end{aligned} \quad (9)$$

— полный эффективный потенциал единицы объема квази-2D системы, взятый фактически в приближении самосогласованного, или среднего, поля, но с учтенными θ -флуктуациями. Термодинамический потенциал (9) и соответствующее ему уравнение (8) учитывают, однако, лишь классические флуктуации поля $\Phi_j(x, y)$; в то же время квантовые флуктуации, требующие специального рассмотрения, должны быть существенными либо при предельно низких температурах, либо при очень малых n_f . И то, и другое может оказаться трудным для какой-либо экспериментальной проверки, поскольку, как известно, при $n_f \lesssim 0,05$ медные оксиды, проводимость которых обусловлена их

иновалентным допированием, претерпевая переход металл — диэлектрик, становятся непроводящими.

Явное выражение для T_c находится из условия существования ненулевого решения уравнения (8) при учете (6) и (7). Считая, как обычно, что в точке перехода $\langle \cos \theta \rangle \ll 1$, и проводя в правой части (8) необходимое разложение, после вычисления функционального интеграла (уже при $t_J \rightarrow 0$) приходим к окончательному выражению

$$T_c^3 = N_c^3 t_J J^2(\mu, \Delta, T_c) \left(\frac{\Delta}{\omega_0} \right)^2, \quad (10)$$

где $J(\mu, \Delta, T)$ определено в (5). Эта формула, как будет показано, дает зависимость $T_c(n_f)$, отличную от тех, которые были получены ранее для квази-1D [23] и 3D [7] случаев. Кроме того, из (10) следует, что, во-первых, как и должно быть, $T_c = 0$ при $t_J = 0$ и, во-вторых, эта формула оказывается справедливой и в пределе больших n_f , когда $\mu = \varepsilon_F$ и в системе формируется куперовское, а не локальное спаривание.

Нетрудно получить асимптотики для обеих температур T_c^{BCS} и T_c . Действительно, в области малых n_f , когда $\varepsilon_F / \omega_0 \ll 1$, температура T_c^{BCS} удовлетворяет уравнению $T_c^{BCS} \ln(T_c^{BCS} / \varepsilon_F) = \omega_0 \exp(-4\pi / g_{ph}^2 m)$, из которого прямо следует, что $\partial T_c^{BCS} / \partial \varepsilon_F \rightarrow \infty$, если $\varepsilon_F \rightarrow 0$. В этой же области

$$T_c = \frac{N_c}{2} \left[\frac{1}{\pi^2} \frac{t_J}{\omega_0} \exp(-4\pi / g_{ph}^2 m) \right]^{1/3} \varepsilon_F \sim N_f, \quad (11)$$

где N_f — объемная концентрация свободных носителей; другими словами, критическая температура оказывается линейной функцией n_f , а, например, величина $2\Delta(T=0) / T_c \sim n_f^{-1/2}$ много больше своего канонического (БКШ) значения $\approx 3,5$. Разумеется, степень n_f , отличная от тех, которые определены в [7,23], фактически есть следствие двумерности, поскольку при анализе (8) и нахождении (10) константа туннелирования полагалась малым параметром. Рост последнего, с одной стороны, увеличивает, как видно из (11), T_c , а с другой — если нарушится критерий малости, может привести к поправкам, которые линейную зависимость (11) «заменяют» на $T_c \sim N_f^{2/3}$, полученную Дмитренко и Куликом.

В области больших n_f , или $\varepsilon_F / \omega_0 \gg 1$ и $\mu = \varepsilon_F$, температура $T_c^{BCS} \sim \Delta(T=0) = \text{const}$ и зависимость $T_c^{BCS}(n_f)$ соответствует теории БКШ — Элиашберга. А поскольку в ней для 2D случая плотность состояний от энергии не

зависит, то и $T_c^{BCS}(n_f)$ оказывается постоянной. В то же время T_c , как непосредственно следует из (10), продолжает расти, лишь асимптотически приближаясь к T_c^{BCS} , так что $T_c^{BCS} - T_c \rightarrow 0$, причем подобное поведение сохраняется при всех $\alpha \leq 1$ (см. (3)). Более интересным представляется неравенство $\alpha > 1$: в этом случае возникает точка ε_F^{cr} (или, что то же самое, n_f^{cr}), в которой $T_c^{BCS} = T_c = 0$. Другими словами, при $n_f \geq n_f^{cr}$ квази-2D металл с деградирующими длинноволновыми промежуточными бозонами должен терять свои сверхпроводящие свойства. Тогда из (4) можно получить, что если $\varepsilon_F \lesssim \varepsilon_F^{cr} = \omega_0(\alpha - 1) \exp(-4\pi / g_{ph}^2 m)$, то

$$T_c^{BCS} = \omega_0 \ln^{-1} \frac{2\varepsilon_F^{cr}}{\varepsilon_F^{cr} - \varepsilon_F}; \quad (12)$$

$$T_c = \omega_0 \left[\frac{3^5}{2^{12}\pi^2} N_c^3 \frac{t_J(\varepsilon_F^{cr})^{12}}{\omega_0^{13}} (\alpha - 1)^{10} \left(1 - \frac{\varepsilon_F}{\varepsilon_F^{cr}} \right) \right]^{5/11}.$$

При этом во всех случаях $T_c < T_c^{BCS}$, т.е. область $T_c \leq T \leq T_c^{BCS}$, как и в 2D случае, фактически является псевдощелевой, поскольку в ней $\Delta \neq 0$. Анализ этой области проведен в работах [5,16]. При этом, однако, необходимо иметь в виду, что $\Delta(T_c^{BCS}) = 0$ только в приближении БКШ и что в реальных ситуациях $\Delta(T)$, или псевдощель, может быть в принципе конечной и в области $T > T_c^{BCS}$.

Заключение

Таким образом, конечная температура установления однородного параметра порядка полностью контролируется межслоевым туннелированием (чем оно больше, тем больше T_c , которая, в свою очередь, всегда меньше T_c^{BCS}). В квази-2D системах также возможно существование области псевдощелевой фазы, обладающей необычными свойствами. Так, в ней многие термодинамические величины (например, парамагнитная восприимчивость [17]) ведут себя необычно и оказываются гладкими в окрестности истинной температуры сверхпроводящего перехода T_c . Конечно, рассмотренная модель, хотя и описывает кроссовер от сверхпроводимости при малых концентрациях носителей (сверхтекучести локальных пар) к сверхпроводимости БКШ, не может дать полного представления о поведении систем ВТСП, которым, строго говоря, не могут быть адекватны модели со свободными (а не с сильно коррелированными) носителями. Обобщение

теории на случай сильных (халбардовских) межэлектронных корреляций будет проведено в отдельной публикации.

Мы испытываем глубокое удовлетворение и в то же время ответственность, выполняя эту работу к юбилею одного из корифеев физики и энтузиастов техники низких температур академика НАН Украины Игоря Михайловича Дмитренко. Его многолетние, общепризнанные экспериментальные исследования создали основы и способствовали становлению большого числа фундаментальных направлений физики сверхпроводимости и ее применений: джозефсоновской и микроконтактной спектроскопии, неравновесной сверхпроводимости, изучения свойств резистивного состояния и квантовых интерференционных явлений и др.

1. Y. I. Uemura, in: *Proc. Workshop in Polarons and Bipolarons in High- T_c Superconductors and Related Materials*, Cambridge, 1994, E. Salje (ed.), Cambridge, University Press (1995).
2. V. J. Emery and S. Kivelson, *Nature* **374**, 434 (1995).
3. В. М. Локтев, *ФНТ* **22**, 3, 490 (1996).
4. D. Pines, *Tr. J. Physics* **20**, 535 (1996).
5. V. M. Loktev and S. G. Sharapov, *Cond. Mat. Phys.* No 11, 131 (1997).
6. И. М. Дмитренко, *В мире сверхпроводимости*, Наукова думка, Киев (1981).
7. I. M. Dmitrenko and I. O. Kulik, *Phys. Status Solidi* **B64**, K13 (1974).
8. А. И. Ахизер, С. В. Пелетминский, А. А. Яценко, *УФЖ* **39**, 1852 (1993).
9. M. Randeria, in: *Bose-Einstein Condensation*, A. Griffin, D. W. Snoke, and S. Stringari (eds.), Cambridge, University Press, N.Y. (1995).
10. J. B. Torrance, Y. Tokura, A. I. Nazzari, A. Beziinge, T. C. Huang, and S. S. P. Parkin, *Phys. Rev. Lett.* **61**, 1127 (1988).
11. S. Uchida, T. Ido, H. Takagi, T. Arima, Y. Tokura, and S. Tajima, *Phys. Rev.* **B43**, 7942 (1991).
12. Y. I. Uemura, *Preprint cond-mat/9706151* (1997).
13. D. Mihailovic, B. Podobnic, J. Demsar, G. Wagner, and J. Evetts, *Preprint cond-mat/9801049* (1998).
14. H. Ding, T. Yokoya, J. C. Campuzano, T. Takahashi, M. Randeria, M. R. Norman, T. Mochiku, K. Kadowaki, and J. Giapintzakis, *Nature* **382**, 51 (1996).

15. B. G. Levi, *Phys. Today* **49**, 17 (1996).
16. В. П. Гусынин, В. М. Локтев, С. Г. Шарапов, *Письма в ЖЭТФ* **65**, 170 (1997); *ФНТ* **23**, 816 (1997).
17. В. П. Гусынин, В. М. Локтев, С. Г. Шарапов, *ФНТ* **23**, 1247 (1997).
18. B. Keimer, N. Belk, R. J. Birg, A. Cassanho, C. Y. Chen, M. Greven, M. A. Kastner, and G. Shirane, *Phys. Rev.* **B46**, 14034 (1992).
19. H. Takagi, R. J. Cava, M. Marezio, B. Batlogg, J. J. Krajewski, W. F. Peck, Jr., P. Bordet, and D. E. Cox, *Phys. Rev. Lett.* **68**, 3777 (1992).
20. T. Nagano, Y. Tomioka, Y. Nakayama, K. Kishio, and K. Kitazawa, *Phys. Rev.* **B48**, 9689 (1993).
21. М. А. Иванов, В. М. Локтев, Ю. Г. Погорелов, *ЖЭТФ* **101**, 596 (1992).
22. В. М. Локтев, *СФХТ* **4**, 2293 (1991).
23. К. Ефетов, А. И. Ларкин, *ЖЭТФ* **66**, 2290 (1974).
24. A. A. Abrikosov, *Phys. Rev.* **B55**, R6149 (1997).
25. P. W. Anderson, *Science* **268**, 1154 (1995).
26. В. Л. Гинзбург, Е. Г. Максимов, *СФХТ* **5**, 1543 (1992).
27. N. M. Plakida and V. S. Udovenko, *Mod. Phys. Lett.* **B6**, 541 (1998).
28. А. С. Александров, А. Б. Кребс, *УФН* **162**, 1 (1992).
29. I. V. Stasyuk, A. M. Shvaika, and E. Schachinger, *Physica* **C213**, 57 (1993).
30. В. А. Москаленко, *ТМФ* **111**, 439 (1997); *там же* **113**, 432 (1997).
31. А. А. Абрикосов, Л. П. Горьков, И. Е. Дзялошинский, *Методы квантовой теории поля в статистической физике*, Физматгиз, Москва (1962).
32. Ю. М. Иванченко, Ю. В. Медведев, *Препринт ДонФТИ-84-4(79)*, Донецк ДонФТИ НАН Украины (1984).

Order parameter fluctuations and transition temperature in quasi-2D metals with arbitrary carrier density

V. M. Loktev and V. M. Turkowski

It is shown that the order parameter fluctuations result in a power dependence of the superconducting transition temperature in quasi-2D metals on the fermion hopping probability between layers. The dependence of this temperature on carrier concentration is determined for a model with indirect intercarrier attraction. The transition is found to take place at temperatures lower than is evident from the BCS theory.